

# Зонная структура SrFeAsF и CaFeAsF – базисных фаз новой группы бескислородных FeAs сверхпроводников

И. Р. Шеин, А. Л. Ивановский<sup>1)</sup>

Институт химии твердого тела Уральского отд. РАН, 620041 Екатеринбург, Россия

Поступила в редакцию 20 октября 2008 г.

Представлены результаты первопринципных FLAPW-GGA расчетов зонной структуры недавно синтезированных четырехкомпонентных фторарсенидов SrFeAsF и CaFeAsF – базисных фаз новой группы бескислородных FeAs-сверхпроводников. Для SrFeAsF и CaFeAsF определены энергетические зоны, распределения плотностей электронных состояний, эффективные атомные заряды, топология поверхности Ферми, коэффициенты низкотемпературной электронной теплоемкости и молярной парамагнитной восприимчивости Паули, которые обсуждаются в сопоставлении с аналогичными данными для оксиарсенида LaFeAsO – базисной фазы семейства недавно открытых высокотемпературных ( $T_C \sim 26\text{--}56\text{ K}$ ) кислородсодержащих FeAs-сверхпроводников.

PACS: 71.15.Mb, 71.18.+y, 74.25.Jb

Важнейшим событием 2008 г. в области сверхпроводимости явилось открытие [1] нового класса FeAs сверхпроводников (СП), который включает три группы так называемых  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$ ,  $\langle\langle 122 \rangle\rangle$  и  $\langle\langle 111 \rangle\rangle$  фаз, см. [1–5]. Среди них наиболее многочисленную группу составляют [3] кислородсодержащие четырехкомпонентные  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$  фазы – оксиарсениды LnFeAsO (где Ln = La, Ce … Gd, Tb, Dy), для представителя которых – системы  $Gd_{1-x}Th_yFeAsO$  – достигнута максимальная на сегодняшний день критическая температура  $T_C \sim 56\text{ K}$  [6].

Упомянутые  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$  фазы являются анизотропными (квазидвумерными) системами, кристаллическая структура которых составлена молекулярными слоями  $[LnO]^{\delta+}$ , чередующимися со слоями  $[FeAs]^{\delta-}$ . В недопированном состоянии эти системы имеют сложную магнитную структуру с образованием волн спиновой плотности и при понижении температуры испытывают фазовый переход из тетрагональной в моноклинную (орторомбическую) структуру.

Имеющиеся экспериментальные и теоретические данные (см. [1–10]) свидетельствуют, что возникновение сверхпроводящего состояния для этих материалов тесно связано с подавлением указанных структурного и магнитного переходов в результате их электронного и (или) дырочного допирования, а также при их барической обработке.

Открытие сверхпроводимости для оксиарсенидов LnFeAsO инициировало интенсивный поиск их изоструктурных (структурный тип ZrCuSiAs, пространственная группа  $P4/nmm$ ) аналогов, которые могли бы стать

базисными фазами новых сверхпроводящих материалов. В этом направлении к сегодняшнему дню заметные успехи достигнуты в синтезе и исследовании физических свойств ряда оксиарсенидов типа LnMPnO (где M = Ni, Co и Pn = N, P, Sb, Bi) [3, 11–15]. Подчеркнем, что кристаллическая структура всех упомянутых фаз включает кислородсодержащие молекулярные слои  $[LnO]^{\delta+}$ .

В связи с изложенным большой интерес представляют недавние сообщения [16–19] о синтезе новой группы бескислородных четырехкомпонентных  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$  фаз – фторарсенидов AFeAsF (где A = Sr, Ca, Eu). Как и их изоструктурные аналоги – оксиарсениды LnMPnO – данные фазы имеют тетрагональную квазидвумерную структуру (типа ZrCuSiAs), образованную чередованием слоев …  $[AF]^{\delta+}/[FeAs]^{\delta-}/[AF]^{\delta+}/[FeAs]^{\delta-}/[AF]^{\delta+} \dots$  Фторарсениды SrFeAsF, CaFeAsF и EuFeAsF проявляют [16, 10] аномалии на температурных зависимостях электросопротивления, теплопроводности и магнитной восприимчивости при 175, 118 и 153 K, соответственно. Аналогичные аномалии, относимые за счет возникновения волн спиновой плотности, обнаружены для известных кислородсодержащих  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$  фаз [1–3, 6–10] и рассматриваются как характерный признак, позволяющий ожидать возникновения в соответствующих материалах сверхпроводимости. Более того, при допировании SrFeAsF кобальтом был обнаружен (для состава SrFe<sub>0.875</sub>Co<sub>0.125</sub>AsF) критический переход с  $T_C \sim 4\text{ K}$  [17], а для образца номинального состава Sr<sub>0.8</sub>La<sub>0.2</sub>FeAsF сообщают [19] о критическом переходе с  $T_C \sim 31\text{ K}$ .

<sup>1)</sup>e-mail: ivanovskii@ihim.uran.ru

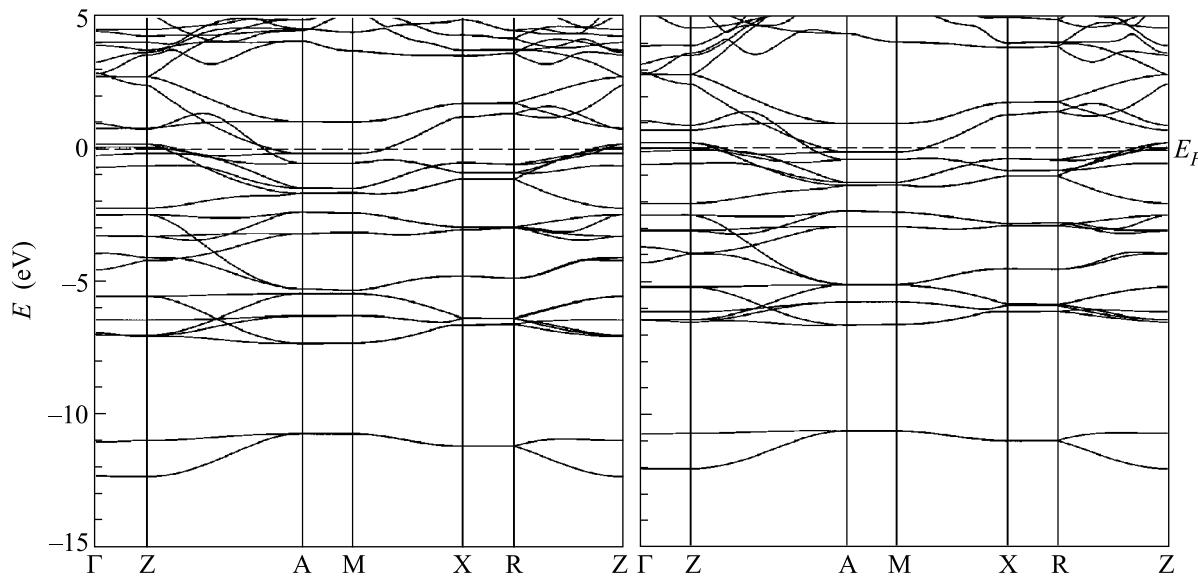


Рис.1. Энергетические зоны CaFeAsF (слева) и SrFeAsF (справа)

Эти предварительные результаты позволили предположить [19], что на основе фторарсенидов AFeAsF может быть получено семейство новых бескислородных сверхпроводящих материалов, которое существенно расширит известный к сегодняшнему дню класс FeAs сверхпроводников.

В настоящей работе в рамках первопринципного зонного метода FLAPW-GGA представлены первые результаты исследований зонной структуры двух слоистых фторарсенидов SrFeAsF и CaFeAsF как базисных фаз прогнозируемого семейства новых бескислородных сверхпроводящих материалов.

Расчеты SrFeAsF и CaFeAsF проведены полно-потенциальным методом присоединенных плоских волн (FP-LAPW, код WIEN2k) [20] с обобщенной градиентной аппроксимацией (GGA) обменно-корреляционного потенциала [21]. Набор плоских волн  $K_{\max}$  определялся как  $R_{MT} \cdot K_{\max} = 7.0$ . Интегрирование по зоне Бриллюэна (ЗБ) проведено методом тетраэдров с использованием сетки  $10 \times 10 \times 4$  для  $40 k$ -точек в неприводимой части ЗБ. Критерий сходимости для полной энергии составлял 0.01 mRy, для зарядов – 0.1 м.е.

На первом этапе проведена полная структурная оптимизация рассчитываемых фаз как по параметрам решетки, так и по атомным позициям, табл.1. Видно, что для SrFeAsF отличия между полученными нами параметрами решетки и экспериментальными данными не превышают 2%, что находится в пределах расхождения между имеющимися экспериментальными значениями [16–19]. При переходе SrFeAsF → CaFeAsF происходит уменьшение парамет-

Таблица 1

**Оптимизированные постоянные решетки ( $a, c, \text{\AA}$ ), внутренние параметры ( $z_{\text{As}}, z_{\text{Sr}, \text{Ca}}$ ), длины связей ( $d(\text{Fe}-\text{As}), \text{\AA}$ ), углы связей ( $\text{As}-\text{Fe}-\text{As}$ , град) и объемы элементарных ячеек ( $V_o, \text{\AA}^3$ ) для тетрагональных слоистых фаз SrFeAsF и CaFeAsF по данным FLAPW-GGA расчетов**

Фаза/параметр	SrFeAsF	CaFeAsF
$a$	4.0055 (3.9930 [16]; 3.999 [17]; 4.004 [18]; 4.011 [19])	3.9049
$c$	8.8049 (8.9546 [16]; 8.973 [17]; 8.971 [18]; 8.965 [19])	8.3565
$c/a$	2.1982 (2.2426 [16]; 2.2438 [17]; 2.2405 [18]; 2.2351 [19])	2.1400
$z_{\text{As}}$	0.6397 (0.6527 [16])	0.6525
$z_{\text{Sr}, \text{Ca}}$	0.1665 (0.1598 [16])	0.1588
$d(\text{Fe}-\text{As})$	2.350 (2.420 [16])	2.331
$(\text{As}-\text{Fe}-\text{As})$	105.89 (108.6 [16])	107.38
$V_o$	141.27 (142.77 [16])	127.42

\* В скобках приведены имеющиеся экспериментальные данные.

ров решетки (что легко объяснимо с учетом разницы ионных радиусов  $R(\text{Sr}^{2+}) = 1.12 \text{\AA} > R(\text{Ca}^{2+}) = 0.99 \text{\AA}$ ), однако сжатие кристалла по оси  $z$  ( $\sim 0.5 \text{\AA}$ ) оказывается больше, чем в плоскости  $xy$  ( $\sim 0.1 \text{\AA}$ ). Сходный эффект анизотропной деформации кристаллов при ионных замещениях был отмечен также для ряда изоструктурных оксиликнитидов  $\text{LnMPnO}$ , см. [15].

Зонная структура и плотности состояний (ПС) SrFeAsF и CaFeAsF представлены на рис.1 и 2. Группы низкоэнергетических зон, расположенных в интер-

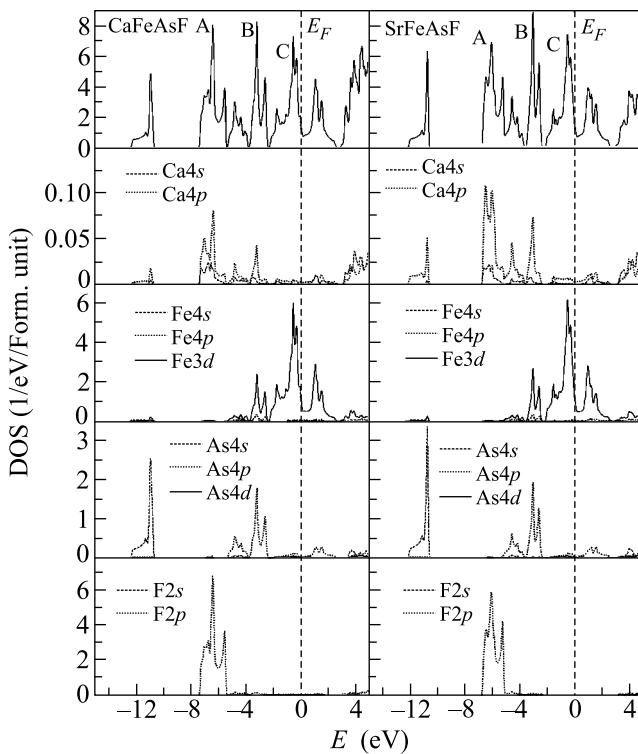


Рис.2. Полные (вверху) и парциальные плотности состояний CaFeAsF и SrFeAsF

вале энергий от  $-12.4$  до  $-10.8$  эВ ниже уровня Ферми ( $E_F$ ), образованы в основном As 4s состояниями. Группа занятых валентных зон располагается в интервале от  $-6.8$  эВ до  $E_F$  (SrFeAsF) и от  $-7.3$  эВ до  $E_F$  (CaFeAsF). Видно (рис.2), что в этом энергетическом интервале четко выделены три группы состояний – полосы A, B и C. Полосы A образованы в основном F 2p с примесью Sr(Ca) sp состояний, полосы B – смешанными (гибридными) Fe 3d – As 4p состояниями, тогда как прифермьевская область (полоса C, в интервале от  $\sim -2.2$  эВ до  $E_F$ ) состоит в основном из Fe 3d состояний, которые вносят основной вклад в полную ПС на уровне Ферми ( $N^{\text{tot}}(E_F)$ , табл.2), то есть ответственны за проводящие свойства фторарсенидов.

Пересекающие  $E_F$  квазиплоские Fe 3d-подобные зоны образуют систему электронных и дырочных карманов (рис.1), формируя характерную топологию поверхности Ферми (ПФ) рис.3, которая состоит из двух дырочных цилиндров в центре ЗБ (направление  $G-Z$ ) и двух электронных листов – вдоль ее граней (направление  $A-M$ ). Сходное строение ПФ получено для сверхпроводящих  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$ , а также  $\langle\langle 122 \rangle\rangle$  и  $\langle\langle 111 \rangle\rangle$  фаз, см. [4, 5, 22].

Уровень Ферми располагается на крутом склоне пика C вблизи локального минимума, разделяющего связывающие и антисвязывающие Fe 3d-подобные зо-

Таблица 2

Полные  $N^{\text{tot}}(E_F)$  и парциальные  $N^l(E_F)$  плотности состояний на уровне Ферми (сост./эВ форм.ед.), коэффициенты низкотемпературной электронной теплоемкости  $\gamma$  (мДж · К $^{-2}$  · моль $^{-1}$ ) и молярной парамагнитной восприимчивости Паули  $\chi$  ( $10^{-4}$  э.м.е./моль) для SrFeAsF и CaFeAsF по данным FLAPW-GGA расчетов

фаза/параметр	SrFeAsF	CaFeAsF
$N^{\text{Fe}d}(E_F)$	1.188	1.529
$N^{\text{As}}(E_F)$	0.039	0.040
$N^{\text{tot}}(E_F)$	1.540	1.895
$\gamma$	3.630	4.466
$\chi$	0.496	0.610

ны, рис.2. Следовательно, электронное или дырочное легирование SrFeAsF и CaFeAsF будет приводить к резким изменениям плотности состояний на уровне Ферми, существенно влияя на проводящие и магнитные свойства данных кристаллов. Из приведенных в табл.2 величин видно, что величина  $N(E_F)$ , как и определяемые ею коэффициенты низкотемпературной теплоемкости ( $\gamma$ ) и молярной парамагнитной восприимчивости Паули ( $\chi$ ), возрастают при переходе от SrFeAsF к CaFeAsF.

Одним из важнейших вопросов при изучении новых FeAs-сверхпроводников является определение их основного магнитного состояния, см. [1–15, 22]. В рамках FLAPW-GGA расчета в качестве основного для SrFeAsF и CaFeAsF получено немагнитное (НМ) решение; однако, по нашим оценкам, полная энергия НМ фазы SrFeAsF лишь на  $\sim 0.001$  эВ/форм.ед. меньше, чем для ее ферромагнитного состояния, для которого магнитный момент на атоме железа составляет  $0.15 \mu_B$ . Следовательно, данные фторарсениды (как и  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$  оксипниктиды [22]) находятся вблизи границы их магнитной неустойчивости, и можно полагать, что при изменении межатомных расстояний (например, в результате барической обработки) или легирования эти системы перейдут в магнитное состояние.

В заключение рассмотрим особенности межатомных взаимодействий в фторарсенидах SrFeAsF и CaFeAsF. Для описания эффектов орбитальной гибридизации воспользуемся приводимыми на рис.2 плотностями электронных состояний. Эффекты зарядовой поляризации (ионную компоненту связи) обсудим на основе численных оценок атомных зарядов, проведенных по схеме Бейдера [23]. В рамках этой схемы так называемые бейдеровские заряды ( $Q^B$ ) определяются интегрированием электронной плотности ( $\rho$ ) внутри центрированных на атомах

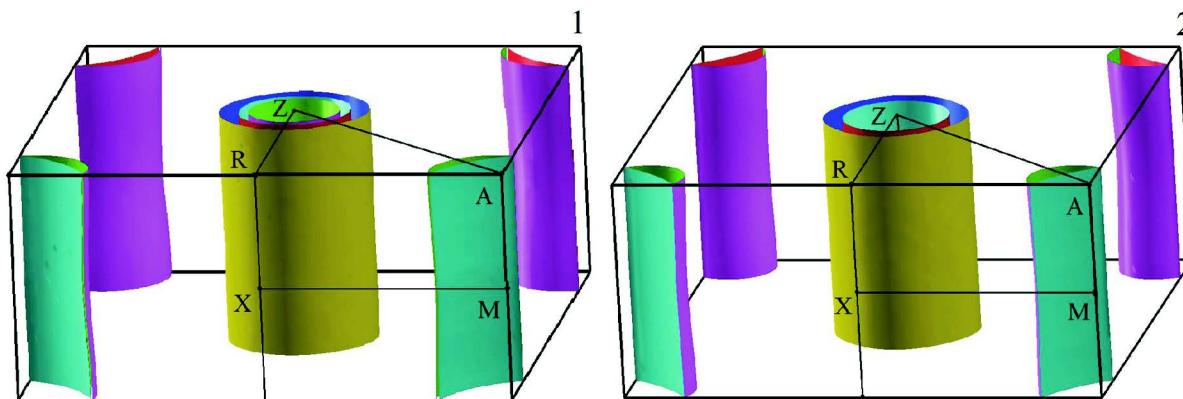


Рис.3. Поверхности Ферми CaFeAsF (слева) и SrFeAsF (справа)

Таблица 3

**Заряды атомов и молекулярных слоев [FeAs], [Sr(Ca)F] (e) для SrFeAsF и CaFeAsF, рассчитанных в рамках ионной модели ( $Q^i$ ), в рамках схемы Бейдера ( $Q^B$ ) и их разности ( $\Delta Q = Q^B - Q^i$ ) в сравнении с аналогичными величинами для оксиарсенида LaFeAsO**

		Sr(Ca,La)	Fe	As	F(O)	[Sr(Ca,La)F(O)]	[FeAs]
SrFeAsF	$Q^i$	+2	+2	-3	-1	+1	-1
	$Q^B$	8.465	7.741	5.950	7.843	16.309	15.585
	$\Delta Q$	0.465	1.741	-2.050	-0.157	0.309	-0.309
CaFeAsF	$Q^i$	+2	+2	-3	-1	+1	-1
	$Q^B$	6.411	7.734	5.986	7.869	14.280	15.603
	$\Delta Q$	0.411	1.734	-2.014	-0.131	0.280	-0.280
LaFeAsO*	$Q^i$	+3	+2	-3	-2	+1	-1
	$Q^B$	9.115	7.722	5.887	7.276	16.391	14.998
	$\Delta Q$	1.115	1.772	-2.113	-0.724	0.391	-0.391

\* По данным [24].

полиэдров, поверхности которых проходят через точки минимумов  $\rho$  в межатомном пространстве.

Из рис.2 видно, что полосы  $A$  и  $B$  включают вклады частично гибридизованных  $F\ 2p$  –  $Sr(Ca)$  орбиталей и  $Fe\ 3d$  –  $As\ 4p$  орбиталей, которые ответственны за формирование ковалентных связей  $Sr(Ca)$ -F, Fe-As и As-As. Эти состояния отделены псевдощелью от прифермьевской полосы  $C$ , которая содержит в основном вклады  $Fe\ 3d$  состояний, причем в этой области состояния атомов [Sr(Ca)F] слоев, как и атомов мышьяка, практически отсутствуют.

Таким образом, в слоях [FeAs] реализуются направленные ковалентные связи Fe-As и As-As (за счет перекрытия  $Fe\ 3d$  –  $As\ 4p$  и  $As\ 4p$  –  $As\ 4p$  орбиталей, см. также [24]) и металлические Fe-Fe связи (за счет делокализованных  $Fe\ 3d$  состояний в прифермьевской области: от  $-2.2$  эВ до  $E_F$ ). Внутри [Sr(Ca)F] слоев имеют место слабые ковалентные связи  $Sr(Ca)$ -F.

Кроме того, с учетом значительных различий электроотрицательностей образующих фторарсени-

ды элементов следует предположить наличие в этих кристаллах ионной компоненты связи. При этом, исходя из формальной валентности атомов и с учетом распределения атомов по молекулярным слоям, ионные формулы SrFeAsF и CaFeAsF могут быть представлены как  $[Sr^{2+}F^{1-}]^{1+}[Fe^{2+}As^{3-}]^{1-}$  и  $[Ca^{2+}F^{1-}]^{1+}[Fe^{2+}As^{3-}]^{1-}$ . Иными словами, ионные связи возникают как между разносортными атомами в каждом слое, так и между соседними молекулярными слоями. Численные расчеты (в рамках схемы Бейдера, табл.3) позволяют оценить величины эффективных зарядов как атомов, так и отдельных слоев. В частности, видно, что “межслоевой” зарядовый перенос  $\Delta Q([Sr(Ca)F] \rightarrow [FeAs])$  составляет 0.309 и 0.280 е для SrFeAsF и CaFeAsF, соответственно. Отметим, что эта величина оказывается меньше, чем для оксиарсенида LaFeAsO (ионная формула  $[La^{3+}O^{2-}]^{1+}[Fe^{2+}As^{3-}]^{1-}$ ), см. табл.3.

Суммируя изложенное, следует заключить, что в фазах SrFeAsF и CaFeAsF реализуется сложная

анизотропная система смешанных ковалентно-ионно-металлических связей, а именно: 1) внутри слоя [FeAs] формируются ковалентные (Fe-As), (As-As), ионные (Fe-As) и металлические (Fe-Fe) связи; 2) внутри слоя [(Sr,Ca)F] формируются ионные (Sr(Ca)-F) и слабые ковалентные (Sr(Ca)-F) связи, и, наконец, 3) между слоями [FeAs] и [(Sr,Ca)F] формируются ионные связи, которые и будут определять общую стабильность этих кристаллов. Отсюда, учитывая металлический тип проводимости во фторарсенидах (осуществляется исключительно за счет [FeAs] слоев), данные фазы (как и родственные  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$ ,  $\langle\langle 122 \rangle\rangle$  и  $\langle\langle 111 \rangle\rangle$  FeAs-системы [4, 5, 11]) можно описать как квазидвумерные ионные металлы.

Таким образом, в настоящей работе в рамках первопринципного FLAPW-GGA метода изучена зонная структура новых фторарсенидов SrFeAsF и CaFeAsF – базисных фаз новой группы бескислородных FeAs-сверхпроводников. Установлено, что эти системы являются немагнитными квазидвумерными ионными металлами со сложной системой анизотропных ковалентно-ионно-металлических межатомных связей. Состав и распределение прифермьевских зон, а также топология ПФ SrFeAsF и CaFeAsF оказываются подобными таковым для известных кислородсодержащих  $\langle\langle 1111 \rangle\rangle$  фаз, на основе которых обнаружена группа высокотемпературных FeAs сверхпроводников.

Наконец, наши расчеты SrFeAsF и CaFeAsF показывают, что эти фазы находятся вблизи границы их магнитной неустойчивости, то есть их сверхпроводящее состояние, которое достигается в результате их легирования [17, 19], будет весьма чувствительным к типу и концентрации вводимых примесей. Это требует постановки дальнейших работ по выбору “оптимальных” типа и концентрации легирующих примесей, что будет способствовать расширению группы новых бескислородных FeAs-сверхпроводников. Кроме того, исходя из имеющихся результатов для группы изоструктурных оксицикликолов LnMPnO [1–15], можно предположить, что факторами, которые могут позволить достичь СП перехода для материалов на основе фторарсенидов, будет их барическая обработка или создание в подрешетках этих кристаллов структурных вакансий.

1. Y. Kamihara, T. Watanabe, M. Hirano, and H. Hosono, *J. Am. Chem. Soc.* **130**, 3296 (2008).
2. M. Rotter, M. Tegel, and D. Johrendt, *Phys. Rev. Lett.* **101**, 107006 (2008).
3. D. Johrendt and R. Pottgen, *Angew. Chem. Int. Ed.* **47**, 4782 (2008).
4. И. Р. Шеин, А. Л. Ивановский, *Письма в ЖЭТФ* **88**, 115 (2008).
5. И. Р. Шеин, А. Л. Ивановский, *Письма в ЖЭТФ* **88**, 378 (2008).
6. C. Wang, L. Li, S. Chi et al., *Europhys. Lett.* **83**, 67006 (2008).
7. H. Takahashi, K. Igawa, K. Arii et al., *Nature* **453**, 376 (2008).
8. G. F. Chen, Z. Li, D. Wu et al., *Phys. Rev. Lett.* **100**, 247002 (2008).
9. Z-A. Ren, J. Yang, W. Lu et al., *Europhys. Lett.* **82**, 57002 (2008).
10. X. H. Chen, T. Wu, G. Wu et al., *Nature* **453**, 761 (2008).
11. В. Л. Кожевников, О. Н. Леонидова, А. Л. Ивановский и др., *Письма в ЖЭТФ* **87**, 747 (2007).
12. S. Lebegue, Z.P. Yin, and W.E. Pickett, arXiv:0810.0376 (2008).
13. A. Kawabata, S.C. Lee, T. Moyoshi et al., arXiv:0808.2912 (2008).
14. J. Ge, S. Cao, and J. Zhang, arXiv:0807.5045 (2008).
15. I. R. Shein, V. L. Kozhevnikov, and A. L. Ivanovskii, *Phys. Rev. B* **78**, 4519 (2008).
16. M. Tegel, S. Johansson, V. Wei et al., arXiv:0810.2120 (2008).
17. S. Matsuishi, Y. Inoue, T. Nomura et al., arXiv:0810.2351 (2008).
18. F. Han, X. Zhu, G. Mu et al., arXiv:0810.2475 (2008).
19. X. Zhu, F. Han, P. Cheng et al., arXiv:0810.2531 (2008).
20. P. Blaha, K. Schwarz, G. Madsen et al. WIEN2k, An Augmented Plane Wave Plus Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties, 2001, Vienna University of Technology, Vienna.
21. J. P. Perdew, S. Burke, and M. Ernzerhof, *Phys. Rev. Lett.* **77**, 3865 (1996).
22. D. J. Singh and M. H. Du, *Phys. Rev. Lett.* **100**, 237003 (2008).
23. R. F. W. Bader, Atoms in Molecules: A Quantum Theory, Intern. Series of Monographs on Chemistry, Clarendon Press, Oxford, 1990.
24. V. V. Bannikov, I. R. Shein, and A. L. Ivanovskii, arXiv:0810.2606 (2008).